

## RISeT – Rete Informativa Scienza e Tecnologia

<i>Mittente</i>	Ambasciata d'Italia a Seoul (Corea) Ufficio Addetto Scientifico e Tecnologico – A.Tata
<b>Titolo: Corea – Nuova memoria DRAM ad altissima velocità di trasferimento dati</b>	
<i>Parole chiave</i>	chips, memorie, DRAM, ICT, architettura WIDE I/O, Samsung Electronics, Corea
<i>Settori/sottosettori</i>	08, 11
<i>Tipo di informazione</i>	Notizie su Progressi di S&T
<i>Redazione</i>	<b>Antonino Tata</b>
<i>E-mail/Tel./fax</i>	<b><u><a href="mailto:sciencekor@yahoo.it">sciencekor@yahoo.it</a></u> – <u><a href="mailto:scitec.ambseoul@esteri.it">scitec.ambseoul@esteri.it</a></u></b> tel. +82-2-796-0491 / fax +82-2-793-5311
<i>Sito web</i>	<a href="http://www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul">www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul</a>

### Testo:

La Soc. coreana Samsung Electronics Co., secondo produttore mondiale di semiconduttori (dopo Intel) e maggior produttore mondiale di memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory) e NAND-Flash (NotAND Memory), ha comunicato di avere sviluppato una nuova memoria DRAM con capacità di trasferimento dati ad una velocità di 8 volte superiore a qualsiasi analogia memoria attualmente in commercio.

Il nuovo chip, con architettura WIDE I/O, ha infatti capacità di trasferimento dati pari a 12.8 Gb/sec, contro l'1.6 Gb/sec dei sistemi analoghi finora disponibili.

Inoltre il nuovo dispositivo riduce dell'87% i consumi rispetto alle precedenti memorie. L'utilizzo della nuova memoria DRAM è previsto in particolare in apparecchiature mobili (smartphones, tablet computer, etc.), ove sia richiesto il funzionamento simultaneo di più programmi in parallelo.

<i>Fonte dell'informazione</i>	Samsung Electronics : <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> Notizie di stampa
<i>Contatto locale</i>	-
<i>Data</i>	07.03.2011